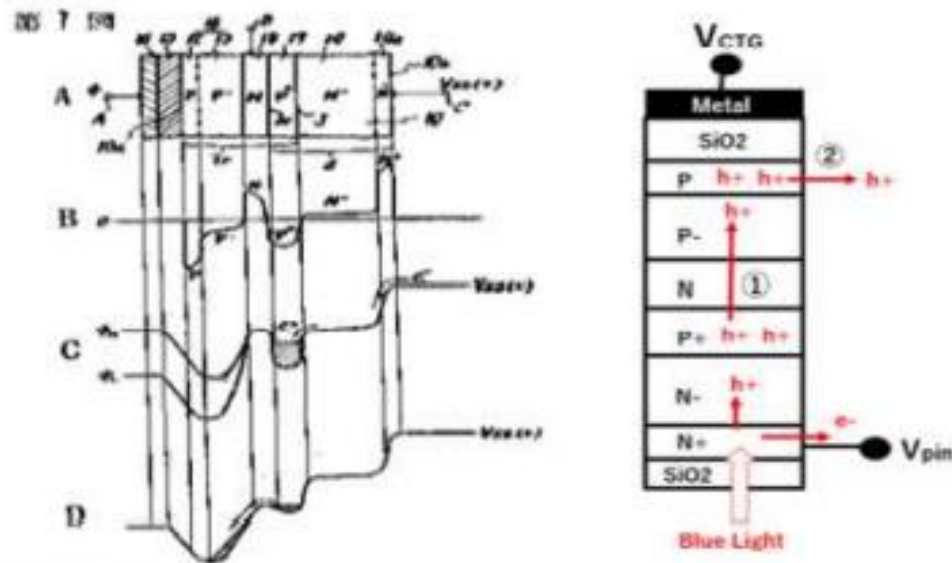


III. ORIGIN OF PINNED BURIED PHOTODIODE

Pinned Buried Photodiode shown in Figure 7
in JPA1975-127646 filed on October 23, 1975



Pinned Buried Photodiode invented by Yoshiaki Hagiwara
as defined in Japanese Patent Claim of
JPA1975-127646 filed on October 23, 1975

特許請求の範囲

半導体基体の一方の主面側に、絶縁膜を介して電荷転送用電極が被着配列される1の導電型の転送領域が形成され、之に対向し且つ之より上記半導体基体の他方の主面側に上記転送領域との間に他の導電型のベース領域を介して受光領域が形成され、上記ベース領域に所定電圧を印加することにより上記受光領域に蓄積した電荷を上記転送領域に転送し、上記電荷転送用電極に所定のクロック電圧を印加して電荷の転送を行うようにしたことを特徴とする固体撮像装置。

Fig 5 A reproduction of Patent Claim and a figure in JPA1975-127646

[5] http://www.aiplab.com/JPA_1975_127646_on_NPNP_type_PPD.html